



现在位置：首页 > 新闻动态 > 综合新闻

新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流
- ▶ 科研项目资金管理

英国利物浦约翰摩尔大学Zhigang Ji博士来微电子所访问交流

2016-09-12 | 编辑：微电子重点实验室 张康玮 | 【大中小】【打印】【关闭】

9月7日，英国利物浦约翰摩尔大学Zhigang Ji博士来微电子所进行学术交流，并作了题为“Advanced CMOS device characterization and modelling for reliability-aware device/circuit co-design”的学术报告。微电子所青促会小组成员、微电子重点实验室副研究员毕津顺主持交流会。全所科研人员、研究生共40余人参加了交流会。

Zhigang Ji在报告中指出，随着半导体制造结点越来越小，电路可靠性问题日受到关注，电路/系统的可靠性问题和更高错误率对制造性设计的要求逐步提高，迫切需要优化设计性能、可靠性、功耗和成本，而传统的电路模型和表征技术已很难满足要求。Zhigang Ji介绍了先进互补金属氧化物半导体（CMOS）器件在电路/系统中的可靠性设计和模型，以及一种改进型缺陷中心框架及其与商业电路模拟器的集成。该框架已被实验证明适合22纳米以下结点技术。他详细讲解了利用该框架改进和提高IMEC的先进Ge/TiN-V器件的技术开发过程，并同与会人员就电路可靠性等领域进行了热烈的学术讨论。

Zhigang Ji博士现任英国利物浦约翰摩尔大学高级讲师，研究重点是先进逻辑和存储器件的退化现象和可靠性建模以及电路/系统的交互问题，先后发表期刊和会议论文60余篇，部分研究成果已被应用到吉时利仪器产品。



交流会现场



附件下载：



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029
 单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn
 京公网安备110402500036号



